

DG0R7E40

400V 0.6/0.7A

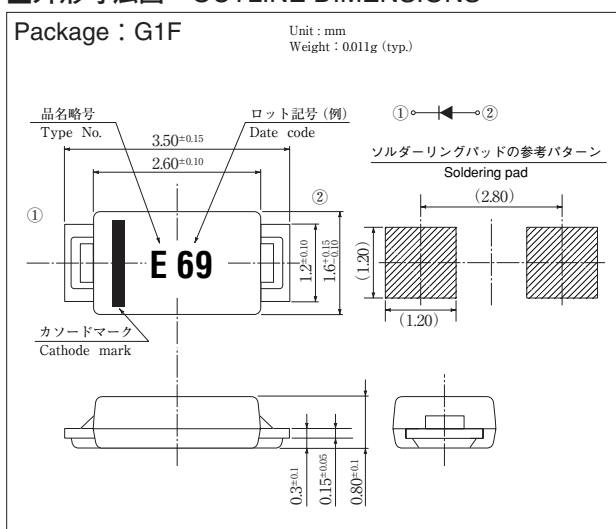
特長

- 耐湿性に優れ高信頼
- 静電気耐性に優れている
- 自動実装対応

Feature

- High-Reliability
- High ESD Capability
- for Auto-Mount

外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS



(製品上の表示については、捺印仕様をご確認ください)

定格表 RATINGS

●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合は $T_l = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	DG0R7E40	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-55~150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj			150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}			400	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz 正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	T _a = 25°C *2 T _a = 64°C *3	0.6 0.7	A
せん頭サーシ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, T _j = 25°C 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, T _j = 25°C		20	A
電流二乗時間積 Current Squared Time	I ² t	1ms ≤ t < 10ms T _j = 25°C		0.8	A ² s

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合は $T_l = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	DG0R7E40	単位 Unit
順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F = 0.7A, パルス測定 Pulse measurement		MAX 1.1	V
逆電流 Reverse Current	I _R	V _R = 400V, パルス測定 Pulse measurement		MAX 10	μA
静電気耐性 Electrostatic Discharge Capability	V _{ESD}	C = 150pF, R = 150Ω, 極性±, 気中放電 Polarity±, Aerial discharge		*1 TYP 30	kV
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{ja}	接合部・周囲間 Junction to Ambient	*2 MAX	210	°C/W
			*3 MAX	120	
	θ _{jl}	接合部・リード間 Junction to Lead	*4 MAX	70	
			*4 MAX	20	

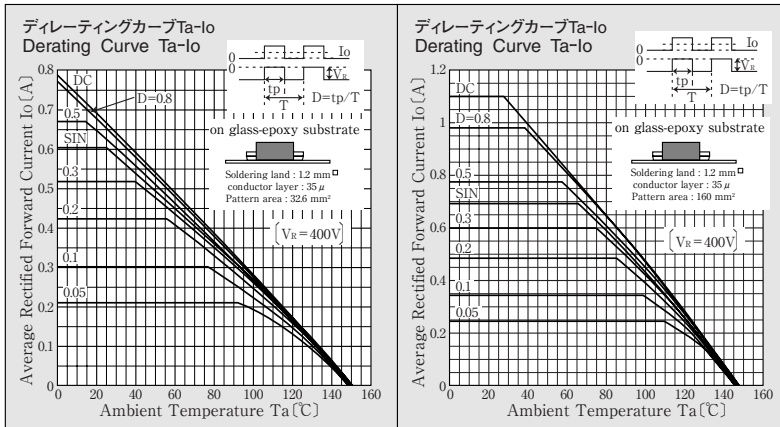
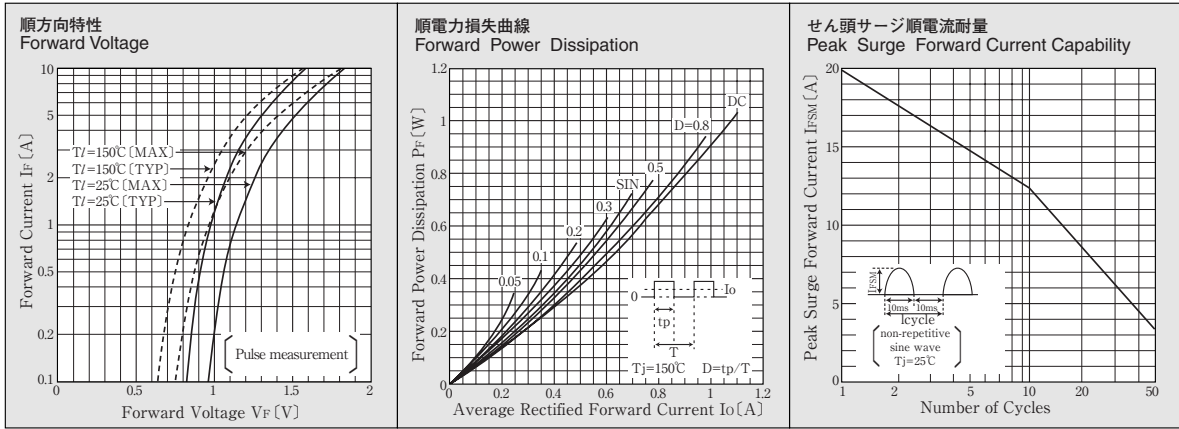
*1: IEC-61000-4-2規定に準拠
It is based on IEC-61000-4-2

*2: ガラエポ基板実装 (1インチ基板) 銅箔パターン総面積32.6mm²
Measured on the 1x1 inch On glass-epoxi substrate (pattern area: 32.6mm²)

*3: ガラエポ基板実装 (1インチ基板) 銅箔パターン総面積160mm²
Measured on the 1x1 inch On glass-epoxi substrate (pattern area: 160mm²)

*4: アルミナ基板実装 (2インチ基板) 銅箔パターン総面積2100mm²
Measured on the 2x2 inch alumina substrate (pattern area: 2100mm²)

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- ・ Sine waveは50Hzで測定しています。
- ・ 50Hz sine wave is used for measurements.
- ・ 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っており、Typicalは統計的な実力を表しています。
- ・ Semiconductor products generally have characteristic variation. Typical is a statistical average of the device's ability.